

## プラナリゼーションCMP委員会会員各位

委員長 檜山浩國(荏原製作所)

前略 会員各位におかれましては、ますますのご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、プラナリゼーションCMP委員会「第151回」研究会として、下記のとおり精密工学会秋季大会オーガナイズドセッションを開催します。このたびはキーノートスピーチに国立研究開発法人産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター長の 奥村 元 先生をお招きします。さらには、翌日9月9日(金)には奥村先生のご協力により、同研究センターの見学会を開催できることになりました。会員各位におかれましてはオーガナイズドセッションと見学会の合同企画に是非ご参加賜り、日頃の研究・技術開発のご参考にされたく、ご案内いたします。

なお、オーガナイズドセッションへのご参加の際には「精密工学会」への参加申し込みが別途必要になりますので、ご注意ください。

### 2016年度精密工学会秋季学術講演会(茨城大学水戸キャンパス) プラナリゼーションCMPとその応用技術専門委員会 「プラナリゼーションCMPとその応用」【第3日目】9月8日(木)開催

時間	所属	講演者	演題
9:00	ニッタ・ハース	戸田智之	研磨スラリー中のシリカ粒子に着目したシリコンウェーハ外周部の平坦度向上
9:20	九州大学	林 照剛	蛍光ナノプローブを用いたブラウン運動解析に基づくナノ粒子粒径計測(第2報)
9:40	日本ポール	角屋正人	CMPスラリーろ過用微細多孔質膜フィルターのろ過寿命延長
10:00	金沢工業大学	富家勇一	難加工基板のCMPにおけるスラリーフロー評価法に関する研究
10:20	休憩		
10:40	国立研究開発法人産業技術総合研究所	奥村 元	産総研におけるSiC研究開発とプロジェクトの紹介
11:00			
11:20	大阪大学	中平雄太	触媒表面基準エッチング法における触媒被毒除去手法の開発
11:40	埼玉大学	細川仁志	酸化剤を用いたSiC鏡面研削に関する研究
12:00	休憩		
12:20	休憩		
12:40	休憩		
13:00	名古屋大学	大鹿真悟	研磨パッドの表面アスペリティモデルに基づく動的な材料特性の分析
13:20	金沢工業大学	早川光祐	両面同時研磨を対象とした上定盤研磨パッドの表面性状測定装置の試作と基礎検討
13:40	名古屋大学	御園生博隆	熱計測を利用した局所的な研磨効率の新しいその場観察手法
14:00	休憩		
14:20	九州大学	林 照剛	低照度ダブルパルスビームを用いたワイドギャップ半導体のナノ表面励起加工に関する研究
14:40	埼玉大学	本明拓也	溶融アルカリ(NaOH)によるSiCの高速鏡面化に関する研究
15:00	大阪大学	宮崎俊亘	表面吸着活性種の輸送を用いたドライ平坦化法の開発

## 【9月9日(金)特別見学会開催のご案内と詳細】

**集合場所:**産総研 つくばセンター つくば西事業所 本館受付前

**集合時間:**9月9日(金)10時

**解散時間:**12時頃

**定員:**約35名

**見学会概要:**近年注目を集めているSiC等のワイドギャップ半導体は、電力制御用半導体として既に鉄道車両やパワーコンディショナー、エアコン等への搭載が開始され、車載向け等、本格的な普及へ向けて盛んに研究開発が行われています。日本における半導体SiC技術の最大の研究開発機関であり、これまで多くの国家プロジェクトを経て発展し続けている産総研 先進パワーエレクトロニクス研究センターを訪問し、結晶成長からウェハ加工、エピ成長・デバイス作製に至るまで、最先端の研究開発現場を見学させていただきます。

**お申し込み先:**プラナリゼーションCMP委員会事務局(担当:三上博子, mikami@global-net.co.jp)

**申込期限:**9月1日(木)(定員を超えた場合は先着順とさせていただきます。なお、9月2日に見学者名簿を先方に提出する必要がありますので、期限を過ぎてのお申込みや当日飛び込み参加はできませんので、ご了承下さい。)